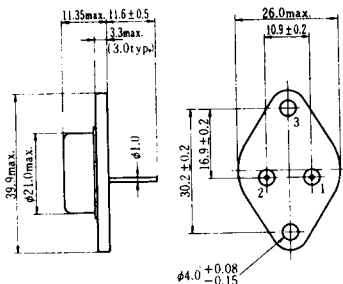


シリコン NPN エピタキシャル形

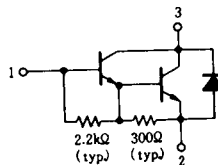
低周波電力増幅用、大電流スイッチング用
2SB639(H)とコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
HIGH CURRENT SWITCHING
Complementary pair with 2SB639(H)



1. ベース: Base
 2. エミッタ: Emitter
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)



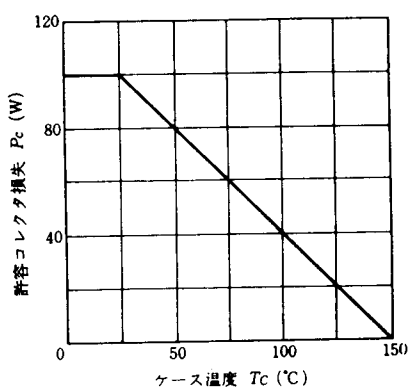
(JEDEC TO-3)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SD629(H)	Unit
コレクタ・ベース電圧		V_{CBO}	100	V
コレクタ・エミッタ電圧		V_{CEO}	100	V
エミッタ・ベース電圧		V_{EBO}	7	V
コレクタ電流		I_C	10	A
せん頭コレクタ電流		$i_{C(peak)}$	15	A
ベース電流		I_B	2	A
許容コレクタ損失		P_C^*	100	W
接合部温度		T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度		T_{stg}	-65~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値
* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION
CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ維持電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=200\text{mA}, R_{BE}=\infty^*$	100	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		V_{BR-EBO}	$I_E=50\text{mA}, I_C=0$	7	—	—	V
コレクタ遮断電流		I_{CBO}	$V_{CB}=100\text{V}, I_E=0$	—	—	100	μA
		I_{CEO}	$V_{CE}=80\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	1.0	μA
直流電流増幅率		h_{FE}	$V_{CE}=3\text{V}, I_C=5\text{A}^*$	1000	—	20000	
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=5\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧		$V_{BE(sat)(1)}$		—	—	2.0	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=10\text{A}, I_B=100\text{mA}^*$	—	—	3.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧		$V_{BE(sat)(2)}$		—	—	3.5	V
ターンオン時間		t_{on}	$I_C=5\text{A}, I_{B1}=-I_{B2}=10\text{mA}$	—	2	—	μs
ターンオフ時間		t_{off}		—	8	—	μs

*パルス測定
* Pulse Test